

WO₃/Cd₂SnO₄的制备及其光催化分解水析氧活性

赵学国，黄祖志，李小红

(景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院，江西 景德镇 333001)

摘要：采用固相反应法合成出尖晶石结构的Cd₂SnO₄，进而在Cd₂SnO₄粉体颗粒表面附着WO₃，制成WO₃/Cd₂SnO₄异质结光催化剂。借助X射线衍射仪、扫描电子显微镜、紫外-可见(UV-Vis)分光光度计等对催化剂粉体进行了表征。在可见光模拟系统中以碘酸钾为电子捕获剂，检测氧气生成速率表征催化剂的光催化性能。结果表明：WO₃附着在Cd₂SnO₄颗粒表面有利于光生电子的转移和光解水析氧反应。WO₃/Cd₂SnO₄催化剂较之纯Cd₂SnO₄催化剂活性显著提高。当WO₃附着量为2.3%(质量分数)时，2.3%WO₃/Cd₂SnO₄光解水析氧速率可稳定在200 μmol/(g·h)。

关键词： 锡酸镉；光催化剂；异质结；光解水；析氧速率

中图分类号：O644 文献标志码：A 文章编号：0454-5648(2015)01-XXXX-06

网络出版时间： 网络出版地址：

Preparation of WO₃/Cd₂SnO₄ and Its Photocatalytic Activity of Water-splitting for Oxygen Evolution

ZHAO Xueguo, HUAN Zuizi, LI Xiaohong

(Jingdezhen Ceramic Institute, School of Materials Science and Technology, Jingdezhen 333001, Jiangxi, China)

Abstract: Cd₂SnO₄ powder with a spinel structure was synthesized by a solid-state method. WO₃ nanoparticles as heterogeneous nanoparticles were loaded onto Cd₂SnO₄ particle surface to form WO₃/Cd₂SnO₄ heterojunction photocatalyst. The WO₃/Cd₂SnO₄ photocatalyst was characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and UV-Vis spectrophotometry, respectively. The photocatalytic activity of the WO₃/Cd₂SnO₄ heterojunction was performed via the O₂ evolution performance under simulated UV-Vis irradiation when KIO₃ was used as a sacrificial agent. The results show that the photocatalytic activity of the WO₃/Cd₂SnO₄ heterojunction was superior to that of pure Cd₂SnO₄ and WO₃ nanoparticles loaded on Cd₂SnO₄ particle surface can improve the interfacial electron transfer and the O₂ evolution. The stable average oxygen evolution rate is 200 μmol/(g·h) when the amount of loaded WO₃ is 2.3% (in mass fraction).

Key words: 锡酸镉；光催化剂；异质结；光解水；析氧速率

近年来，环境问题成为一个日益严重的社会性问题，大量有毒气体和粉尘随意排放到空气和水中，给人赖以生存的大气和水源造成了极大的污染。为了解决环境问题，研究者以太阳辐射能作为研究对象，采用光伏原理将太阳能转化为人们所需要的电能^[1-2]。光催化反应是太阳能利用方法之一，它以太阳光作为能量来源，在室温下通过模拟植物光合作用把水分解为氢气和氧气，产生的氢气可作为燃料代替传统的化石燃料^[3]，而产生的氧气可有效地把水中的有害有机物氧化降解^[4-5]。理解光催化反应原理及过程并设计出高效的光催化剂显得尤为重

收稿日期：2014-04-20。 修订日期：2014-07-17。

基金项目：景德镇陶瓷学院博士启动项目。

第一作者：赵学国（1976—），男，高级工程师。

Received date: 2014-04-20. Revised date: 2014-07-17.

First author: ZHAO Xueguo (1976—), male, Senior Engineer.

E-mail: zhaoxueguo601@163.com

要。

Cd_2SnO_4 半导体材料具有较高的导电率^[4], 且能隙较窄($<3\text{eV}$), 可应用光催化系统^[6]。但研究表明^[7], 纯的 Cd_2SnO_4 催化剂光催化析氧活性较低。半导体复合是提高光催化反应效率的有效手段, 可以使光生载流子在不同能级半导体之间转移, 能有效提高量子效率^[8]。为提高 Cd_2SnO_4 催化剂光解水的能力, 本文在采用固相反应法先合成出 Cd_2SnO_4 粉体基础上, 考虑到 WO_3 具有很高的价带电位(0.5eV)和合适的禁带宽度(2.7eV)^[9], 将 WO_3 附载在 Cd_2SnO_4 催化剂表面, 并在可见光模拟系统中研究了附载的 WO_3 对 Cd_2SnO_4 催化剂光解水析氧性能的影响。

1 实验

1.1 样品制备

实验所用试剂为分析纯的锡酸钠、乙酸镉和钨酸钠, 实验用水为去离子水。

以锡酸钠、乙酸镉等为原料, 通过固相反应法合成出 $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 。将一定量的锡酸钠和乙酸镉溶入水, 两溶液混合后使 $n(\text{Cd}^{2+}):n(\text{Sn}^{4+})=5\sim6$ (摩尔比), 再加入适量氢氧化钠溶液, 使未反应完全的 Cd^{2+} 全部转变为 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 沉淀, 将反应沉淀物过滤并反复用水清洗后, 移置马弗炉内于1000°C煅烧并保温3h, 制得 $\text{CdO}/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 粉体。再用一定量的稀盐酸溶去 CdO 可制备出黄色、纯的 Cd_2SnO_4 催化剂粉体。将一定量的 Na_2WO_4 溶入水中, 然后加入少量盐酸, 形成钨酸溶胶, 再采用浸渍法将钨酸吸附在 Cd_2SnO_4 颗粒表面, 过滤后形成钨酸与 Cd_2SnO_4 复合粉体。将该粉体放入马弗炉中于600°C下焙烧, 即可制备出 $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 复合催化剂粉体。

1.2 样品表征

采用日本理学DMAX-RB X射线粉末衍射仪分析样品的晶型结构, Cu K_{α} 辐射, 靶电压为40kV, 电流为40mA, $\lambda=0.154\text{ nm}$, 石墨单色器滤波, 扫描范围 $2\theta=10^{\circ}\sim70^{\circ}$, 扫描速率为0.02($^{\circ}$)/s。粉末样品压片后进行衍射分析, 采用闪烁计数器控测衍射线强度。采用日本电子JSM25900型扫描电子显微镜观察样品粉末形貌。用日本JEM-2010型透射电子显微镜观察样品颗粒形貌, 阴极为 LaB_6 , 加速电压为200kV。采用Nicolet 7000-C型Fourier红外光谱仪(波数为4000~400 cm^{-1} , 分辨率为4 cm^{-1})对样品平行结构分析, 试样采用高纯KBr与粉末样品压片进行红外光谱测试。采用气相色谱仪(CC-950型, 上海海欣色谱仪器有限公司)进行催化剂活性测试。禁带宽度测试采用Lambda 850紫外-可见(UV-Vis)近红外分光光度计测试样品的禁带宽度。

1.3 样品催化活性表征

使用内置型光源(250W氙灯)光反应器, 气体闭合回路系统(氮气做载气)测试样品的光催化活性。实验中用1%催化剂, 反应液为600mL去离子水和0.30g的 KIO_3 , 在磁力搅拌下, 采用气相色谱对析氧量进行检测。

2 结果与讨论

2.1 物相结构分析

图1为纯 Cd_2SnO_4 和含有不同质量分数 WO_3 的 $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 的XRD谱。从图1中可以看出, 以锡酸钠和乙酸镉为原料, 采用固相反应法在1000°C煅烧3h合成的 Cd_2SnO_4 晶型完整, 其衍射峰与标准卡片(JCPDS 80-1466)中立方相 Cd_2SnO_4 的(130), (200), (111)、(131)、(211)、(221)、(241)和(400)晶面衍射峰相一致。 WO_3 的负载对 Cd_2SnO_4 的衍射峰位置没有影响, 这可能是 WO_3 附着量较少的缘故。

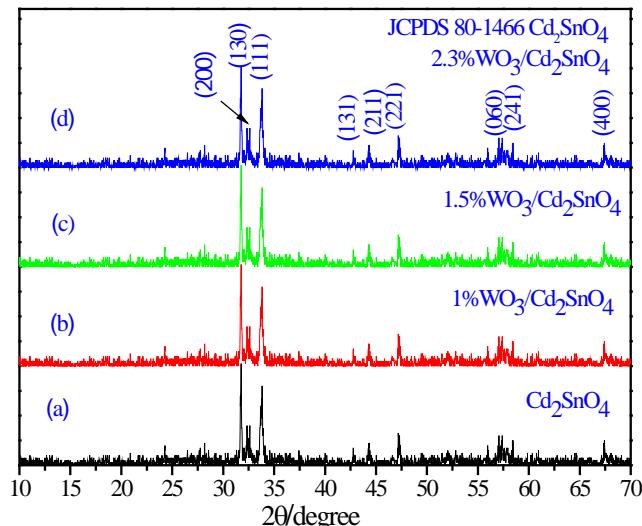


图 1 纯Cd₂SnO₄和不同WO₃含量的WO₃/Cd₂SnO₄样品的XRD谱

Fig. 1 XRD patterns of pure Cd₂SnO₄ and WO₃/Cd₂SnO₄ with different mass fraction of WO₃

2.2 颗粒形貌分析

图 2 为固相反应所制备 2.3% WO₃/Cd₂SnO₄粉体扫描电子显微镜(SEM)照片及其能谱图。从图 2a 中可观察到, 合成的 Cd₂SnO₄ 粉体颗粒外形无规则、大小不均, 大颗粒尺寸可达到 3 μm 左右。图 2b 为图 2a 微区成分分析的能谱图。从图 2b 可见, 各元素的原子数分数分别为 $x(\text{Cd})=27.37\%$, $x(\text{Sn})=14.45\%$, $x(\text{W})=0.95\%$, $x(\text{O})=57.23\%$, 其中摩尔比 $n(\text{Cd})/n(\text{Sn}) \approx 2$, 与 Cd₂SnO₄ 中 $n(\text{Cd})/n(\text{Sn})$ 配比非常接近, 而且检测出的 W 换算为 WO₃ 含量时, 与实际加入量也很吻合。

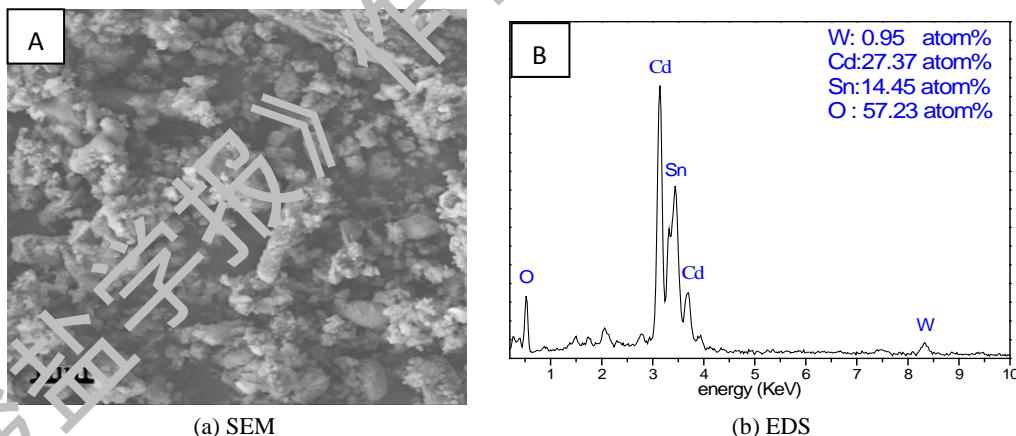
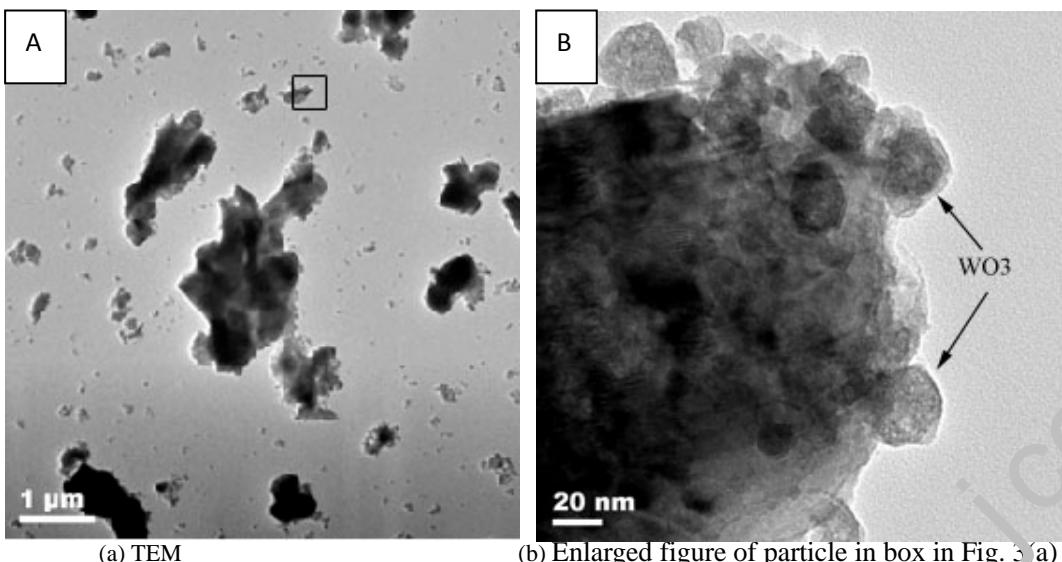


图2 2.3% WO₃/Cd₂SnO₄粉体的SEM照片及其能谱图

Fig. 2 SEM photograph of 2.3% WO₃/Cd₂SnO₄ powder and its corresponding EDS spectrum

图 3 为 2.3% WO₃/Cd₂SnO₄ 粉体 TEM 显微照片及方框中颗粒边缘放大图。从图 3a 可进一步清晰看出, 固相法所合成的 Cd₂SnO₄ 粉体颗粒非常不均匀, 小颗粒在 100~500 nm, 大颗粒尺寸可达到 1~2 μm。对单个颗粒边缘进行放大(图 3b)后可观察到, 有 10~20 nm 左右的小颗粒附着在 Cd₂SnO₄ 颗粒表面上, 结合实验过程及上述能谱分析结果, 这些纳米粒子应为 WO₃。



(a) TEM (b) Enlarged figure of particle in box in Fig. 3(a)

图3 2.3% $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 粉体的TEM照片及其颗粒边缘照片

Fig.3 TEM photograph of 2.3% $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ powder and its particle fringe

2.3 Fourier 红外光谱和紫外可见光吸收光谱分析

图4为纯 Cd_2SnO_4 和2.3% $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 粉体的Fourier红外(FTIR)光谱。从图4可以看出，纯 Cd_2SnO_4 粉体的FTIR谱线中，位于 $400\sim600\text{ cm}^{-1}$ 吸收带是 $\text{O}-\text{Sn}-\text{O}$ 分子振动吸收谱带^[10]；2.3% $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 粉体的FTIR谱线中，位于 850 cm^{-1} 左右的宽吸收峰为 $\text{O}-\text{W}-\text{O}$ 的伸缩振动峰^[11]，表明2.3% $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 样品中含有 $\text{O}-\text{Sn}-\text{O}$ 和 $\text{O}-\text{W}-\text{O}$ 键。表明样品中有锡酸镉和氧化钨，进一步确认了氧化钨附着在锡酸镉上^[11]。

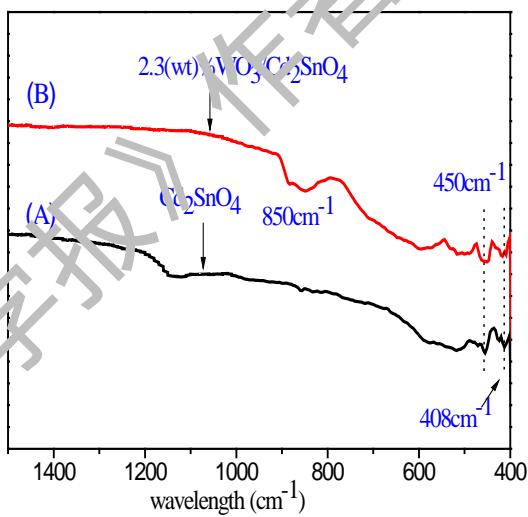


图4 纯 Cd_2SnO_4 和2.3% $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 粉体的FTIR光谱

Fig. 4 FTIR spectra of pure Cd_2SnO_4 and 2.3% $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ powders

图5为 $x\%\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ ($x=0, 1, 1.5, 2.3$)粉体紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱。从图5a可以看出：纯 Cd_2SnO_4 可见光吸收带位于 $300\sim500\text{ nm}$ 之间；当 Cd_2SnO_4 颗粒表面附着少量的 WO_3 后，催化剂粉体对 $400\sim550\text{ nm}$ 之间可见光的吸收出现了明显增强现象，当2.3% WO_3 附载后，催化剂粉体对 450 nm 可见光的吸收比例从76%提高到82%。在相同可见光照射下，增强的

$\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 催化剂对可见光的吸收意味着可产生更多的电子空穴对，进而提高催化剂光解水的活性。此外，根据半导体的吸收系数 α 与光学带隙之间的关系式 $(\alpha h\nu)^2 = A(h\nu - E_g)$ 作图(其中： α 为吸收系数； h 为Planck常数； ν 为光频率； A 为常数； E_g 为禁带宽度；)，如图 5b所示。由 Cd_2SnO_4 可见光吸收光谱的数据可计算出 Cd_2SnO_4 禁带宽度 E_g 为 2.3eV，这与文献所报道的结果相同^[5]。

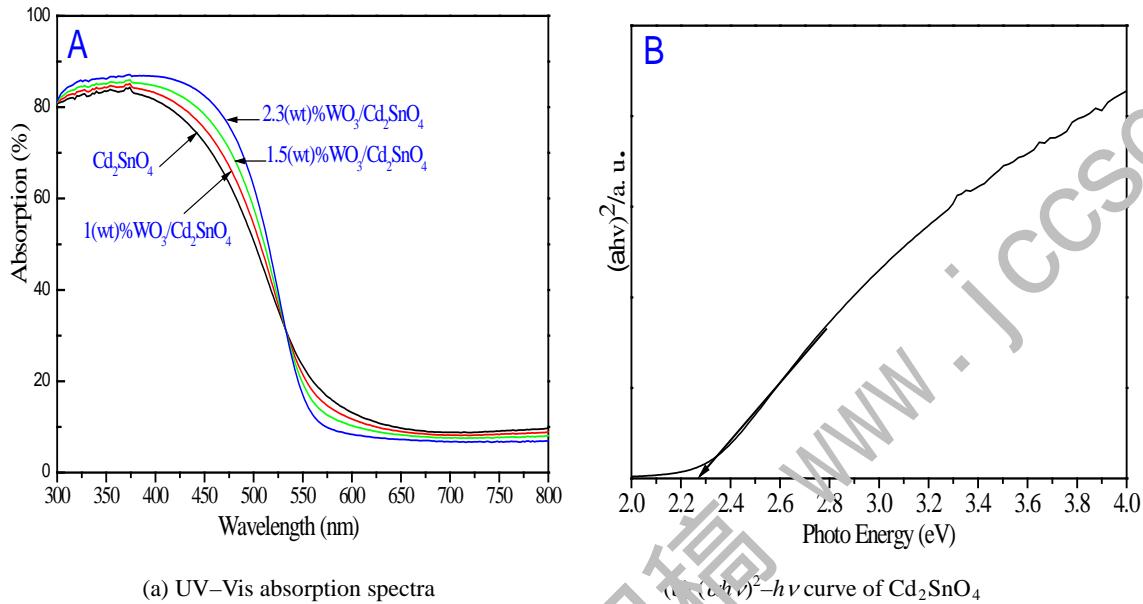


图 5 $x\%$ $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ ($x=0, 0.5, 1, 1.5, 2.3$) 粉体UV-Vis吸收光谱及纯 Cd_2SnO_4 的 $(\alpha h\nu)^2 - h\nu$ 曲线

Fig.5 UV-Vis absorption spectra of $x\%$ $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ ($x=0, 0.5, 1, 1.5, 2.3$) powders and $t(\alpha h\nu)^2 - h\nu$ curve of Cd_2SnO_4 powder

2.4 催化活性表征

$x\%$ $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ ($x=0, 0.5, 1, 1.5$) 催化剂光解水析氧性能受光照时间影响，其关系如图 6 所示。从图 6 可以看出，随着 WO_3 附载量的增多， $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 催化剂光解水析氧能力得到显著的提高，纯 Cd_2SnO_4 催化剂光解水析氧速率约为 $80 \mu\text{mol}/(\text{g}\cdot\text{h})$ ；附载 1% WO_3 后， $1\%\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 催化剂光解水析氧速率提高到 $150 \mu\text{mol}/(\text{g}\cdot\text{h})$ ；进一步增加附载 WO_3 量， $1.5\%\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 催化剂光解水析氧速率增加变缓，但也达到 $180 \mu\text{mol}/(\text{g}\cdot\text{h})$ ；当 WO_3 附载量达到 2.3% 时， $2.3\%\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 催化剂光解水析氧速率增加进一步变缓，达到 $200 \mu\text{mol}/(\text{g}\cdot\text{h})$ 。这说明附载 WO_3 能有效提高 Cd_2SnO_4 光催化剂活性。

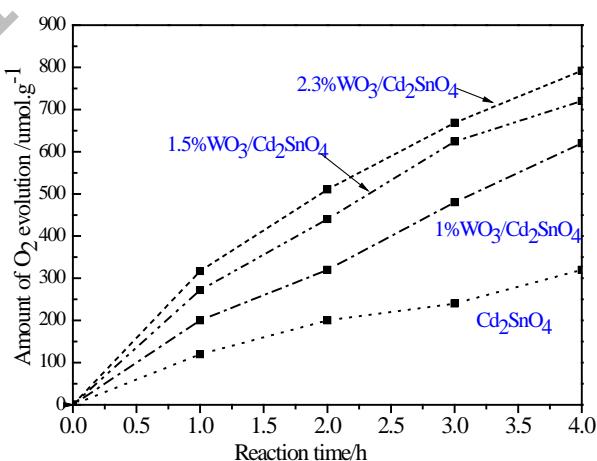


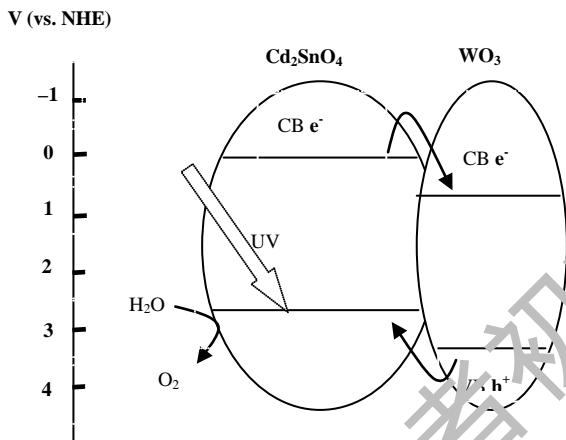
图 6 $x\% \text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ ($x=0, 1, 1.5, 2.3$)催化剂光解水析氧性能与光照时间关系

Fig. 6 Relationship between O_2 evolution performance of $x\% \text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ ($x=0, 1, 1.5, 2.3$) and illumination time

根据文献[12] 可知, 氧化物半导体带边电位强烈受禁带宽度的影响, 其导带、价带电位与禁带关系如下:

$$E_{cb}(\text{V vs NHE}) = 1.23 - E_g(\text{eV})/2, \quad E_{vb}(\text{V vs NHE}) = 1.23 + E_g(\text{eV})/2,$$

其中 E_{cb} 、 E_{vb} 和 E_g 分别表示半导体的导带电位、价带电位及其禁带宽度, NHE(normal hydrogen electrode)表示标准氢电极。将 $E_{vb} = 2.3\text{ eV}$ 代入, 可计算出 Cd_2SnO_4 的导带电位约为 0.1 eV , 价带电位约为 2.4 eV , 这与文献中所报道的结果非常接近^[5]。由于 Cd_2SnO_4 的价带电位远高于水的氧化电位, 因此, Cd_2SnO_4 具有一定的光解水析氧性能。图 7 为 UV-Vis 光照射下 $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 异质结催化剂电子转移示意图。



NHE—Normal hydrogen electrode; CB—Conduction band of semiconductor; VB—Valence band of semiconductor; e^- —Photoinduced electron; h^+ —Photoinduced hole.

图 7 UV-Vis 光照射下 $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 异质结催化剂电子转移示意图

Fig. 7 Schematic diagram of the charge transfer and separation in the $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ photocatalyst under UV-Vis irradiation

从图 7 可以看出, 当少量的 WO_3 附载于 Cd_2SnO_4 颗粒表面后, 由于 WO_3 导带和价带电位($E_{cb}=0.5\text{ eV}; E_{vb}=3.2\text{ eV}$)均比 Cd_2SnO_4 相应的带边电位高, 光照后, Cd_2SnO_4 半导体受激产生的电子在电场作用下会迁移到 WO_3 导带之中, 而 WO_3 受激产生的空穴也会跃迁到 Cd_2SnO_4 价带之中, 这样先生的载流子在 Cd_2SnO_4 与 WO_3 两相间相互分离, 有效提高了催化剂的量子效率。而且聚集在 WO_3 表面的光生电子会为溶液中的 KIO_3 所捕获, 抑制 H_2 的生成, 避免了由光氧化还原反应中产生的 O_2 和 H_2 复合, 提高了 Cd_2SnO_4 光催化剂析氧活性。当继续增加 WO_3 的附载量时, 由于 WO_3 以极为细小的纳米粒子形式附着在半导体颗粒表面上, 具有很大的表面积, 不但减小了半导体颗粒与可见光的接触表面, 而且也减小了半导体颗粒与水的接触面积, 此时增加 WO_3 的附载量并不能快速提高半导体的光催化活性。

3 结 论

以锡酸钠和乙酸镉为原料, 采用固相法制备出尖晶石型 Cd_2SnO_4 粉体, 并在 Cd_2SnO_4 粉体颗粒表面附着 WO_3 , 制成 $\text{WO}_3/\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 异质结光催化剂。 WO_3 附载量对 Cd_2SnO_4 光催化析

氧活性具有一定影响。

- 1) 所制备的Cd₂SnO₄粉体禁带宽度为2.3eV;
- 2) 少量WO₃以纳米颗粒形式(10~20nm)附着在Cd₂SnO₄颗粒表面, 在可见光模拟系统中WO₃能显著提高Cd₂SnO₄光催化析氧活性。
- 3) 当WO₃附载量为2.3%时, 2.3% WO₃/Cd₂SnO₄光解水析氧速率可达到200μmol/(g·h)左右。

参考文献:

- [1] OOSTERHOUT Stefan D, WIENK Martijn M, van Bavel Svetlana S, et al. The effect of three-dimensional morphology on the efficiency of hybrid polymer solar cells[J]. Nat Mater, 2007, 6: 818-824.
- [2] ARICÒ Antonino Salvatore, BRUCE Peter, SCROSATI Bruno, et al., Nanostructured materials for advanced energy conversion and storage devices[J]. Nat Mater, 2005, 4: 365-375.
- [3] 李灿. 太阳能光催化制氢的科学机遇和挑战[J]. 光学与光电技术, 2013, 11(1): 1-6.
LI Chan. Opt Optoelectron Technol (in Chinese), 2013, 11(1): 1-6.
- [4] COUTTS T J, WU X, MULLIGAN W P, et al. High-performance, transparent conducting oxides based on cadmium stannate[J]. J Electron Mater, 1996, 25(6): 933-942.
- [5] 李焕, 张青红, 王宏志, 等. 氧化铋/硅藻土复合光催化剂的制备及其可见光催化性能[J]. 硅酸盐学报, 2013, 41(4): 567-574.
LI Huan, ZHANG Qinghong, WANG Hongzhi, et al. J Chin Ceram Soc, 2013, 41(4): 567-574.
- [6] HUANG X, LV J, LI Z, et al. Electronic structure and visible-light-driven photocatalytic performance of Cd₂SnO₄[J]. J Alloy Compd, 2010, 500(2): 341-344.
- [7] HUANG Xianli, SHI Haifeng, LV Jun, et al. Photocatalytic O₂ evolution performances of Cd_{1+x}In_{2-2x}Sn_xO₄ (x=0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0) conducting oxides [J]. J Phys Chem Solids, 2010, 71: 880-883.
- [8] 施利毅, 古宏晨, 李春忠, 等. SnO₂-TiO₂复合光催化剂的制备和性能[J]. 催化学报, 1999, 20(3): 338-342.
- [9] YOUNG Tae Kwon, KANG Yong Song, WANG In Lee, et al., Photocatalytic behaviour of WO₃-loaded TiO₂ in an O₂ Iontion Reaction[J]. J Catal, 2000, 198(1): 192-199.
- [10] ZHANG Jia Tong, GAO Lian. Synthesis and characterization of antimony-doped tin oxide (ATO) nanoparticle by a new hydrothermal method [J]. Mater Chem Phys, 2004, 87(1): 10-13.
- [11] SALMAOUI S, SEDIRI F, GHARBIN N. Characterization of h-WO₃ nanorods synthesized by thermal process [J]. J Polyhedron, 2010, 29(7): 1771-1775.
- [12] MATSUMOTO Y. Energy Positions of Oxide Semiconductors and Photocatalysis with Iron Containing Oxides [J]. J Solid State Chem, 1996, 126: 227-234.